

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
научного сотрудника
в лаборатории Физики профилированных кристаллов
Вакансия VAC 95060

Тематика исследований

Исследования и разработки в области физического материаловедения сверхширокозонного полупроводника Ga₂O₃ для оптической и силовой электроники.

Трудовая деятельность

- технология роста Ga₂O₃ из газовой фазы (хлоридная газофазная эпитаксия);
- исследование структуры и фазовых переходов α-, β-, γ-, δ-, κ(ε)- фаз Ga₂O₃;
- исследование дефектов структуры Ga₂O₃.
- проведение научных исследований по указанным выше тематикам, включая сбор и анализ актуальной научно-технической информации;
- планирование проведения исследований, составление отчетов по проведенным исследованиям;
- анализ результатов экспериментальных данных;
- подготовка статей для публикации в ведущих мировых журналах, представление полученных результатов на семинарах и конференциях;
- проведение работы по регистрации результатов интеллектуальной собственности;
- участие в выполнении научно-исследовательских работ по проектам с научными фондами и Минобрнауки и др. ведомств РФ;
- участие в выполнении работ в рамках хозяйственных договоров с промышленными партнерами на выполнение за счёт их средств фундаментальных, поисковых и прикладных исследований;
- консультирование студентов и аспирантов, выполняющих НИР в лаборатории Физики профилированных кристаллов.

Требования к кандидату:

- Умение и навыки работы с оборудованием (в частности, с установкой хлоридной газофазной эпитаксии), предназначенным для синтеза и кристаллизации широкозонных полупроводниковых материалов;
- Обеспечение работы оборудования для выращивания эпитаксиальных слоев и объемных кристаллов (в частности, установки хлоридной газофазной эпитаксии);
- Наличие не менее 15 научных статей в рецензируемых физических журналах, индексируемых в базе SCOPUS за последние 4 года;
- Свободное владение английским языком.

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы

- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- сведения о научной (научно-организационной) работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса, список публикаций.

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 26 180 руб.

СТАВКА: 1.0

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: 18 000 руб.

Срок трудового договора – 5 лет

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы:

- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания;
- сведения о научной работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса, список публикаций;

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, ученому секретарю ФТИ им. А.Ф. Иоффе М.И. Патрову, телефон для справок: (812) 297 22 45.